

令和 8 年 6 月 12 日

委員各位

公益社団法人応用物理学会  
半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会  
委員長 小椋厚志

半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会  
第 14 回研究会 開催通知

近年の急速な AI(人工知能)技術の発展に伴い、より高速、低消費電力なメモリの開発が喫緊の課題となっています。これを実現するバックエンド・オブ・ライン(BEOL)材料として、酸化物半導体への注目が急拡大しています。今回、下記のように、BEOL デバイスにフォーカスした酸化物半導体の材料・デバイス技術に関する研究会を開催いたします。多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。

記

日時:2026 年 6 月 30 日(火)13:00-16:50

会場:明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント1階 グローバルホール

[https://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)

テーマ:「酸化物半導体を用いたバックエンド・オブ・ライン(BEOL)デバイス応用の進展」

世話人:森田行則(産総研)、横川凌(広大)

プログラム

|             |                                      |                     |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13:00～13:05 | 開会の挨拶                                | 明治大学 小椋厚志           |
| 13:05～13:10 | はじめに                                 | 産総研 森田行則            |
| 13:10～14:10 | 「ゲートオールアラウンド型酸化物半導体ナノシートランジスタの研究開発」  | 東京大学 小林正治           |
| 14:10～14:55 | 「低消費電力 AI メモリ向け酸化物半導体 DRAM」          | キオクシア 株柳翔一          |
| 14:55～15:15 | 休憩                                   |                     |
| 15:15～16:00 | 「ALD-InOx チャンネル FETs における不純物・過剰酸素制御」 | 産総研 Chen Chia-Tsong |
| 16:00～16:45 | 「P 型酸化物半導体技術動向および研究報告」               | TEL 李 卓             |
| 16:45～16:50 | おわりに                                 | 広島大学 横川凌            |

17:20～19:40 意見交換会(明治大学 駿河台キャンパス グローバルラウンジ)

以上